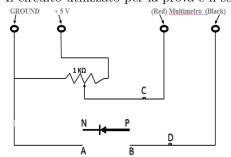
## Lamma Tommaso 0000881007 Turno IV

# Misura della caratteristica di due diodi a giunzione p-n

Lo scopo della prova era la misura della caratteristica di un diodo al Silicio ed uno al Germanio per ricavare il parametro  $\eta V_T$  della legge di Schotky. Il circuito utilizzato per la prova è il seguente



Gli strumenti utilizzati nella prova sono:

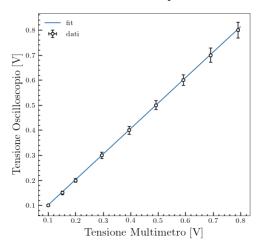
- (i) Potenziometro da  $1k\Omega$
- (ii) Diodi a giunzione p-n: AAZ15/OA47 Germanio, 1N914A/1N4446/1N4148 Silicio
- (iii) Breadboard generica
- (iv) Oscilloscopio ISR 622 ISO-TECH
- (v) Multimetro digitale FLUKE 75
- (vi) Generatore di tensione continua IPS 3303 ISO-TECH

I dati misurati per la calibrazione di multimetro ed oscilloscopio sono:

$V_{mul}[V]$	$\delta V_{mul}[V]$	$V_{osc}[V]$	$\delta V_{osc}[V]$	fondoscala[V]
0.099	0.0003	0.1	0.002	0.02
0.151	0.0004	0.15	0.005	0.05
0.199	0.0005	0.2	0.005	0.05
0.294	0.0006	0.3	0.01	0.1
0.394	0.0008	0.4	0.01	0.1
0.491	0.0009	0.5	0.01	0.1
0.591	0.001	0.6	0.01	0.1
0.691	0.003	0.7	0.02	0.2
0.791	0.003	0.8	0.02	0.2

Ed il rispettivo grafico:

## Calibrazione Oscilloscopio-Multimetro

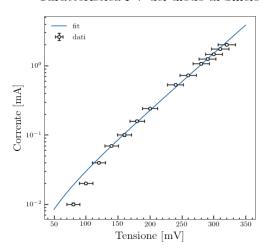


I dati misurati per il diodo al Silicio e al Germanio sono rispettivamente (fondoscala di  $0.1\mathrm{V}$ ):

	$\mathbf{V}[V]$	$\delta V[V]$	I[mA]	$\delta I[mA]$		$\mathbf{V}[V]$	$\delta V[V]$	I[mA]	$\delta I[mA]$
	0.07	0.01	0.01	0.0004		0.4	0.01	0.01	0.0004
	0.08	0.01	0.01	0.0004		0.5	0.01	0.06	0.0009
	0.1	0.01	0.02	0.0005		0.54	0.01	0.12	0.003
	0.12	0.01	0.04	0.0007		0.56	0.01	0.2	0.005
	0.14	0.01	0.07	0.001		0.58	0.01	0.25	0.006
	0.16	0.01	0.10	0.004		0.59	0.01	0.33	0.006
	0.18	0.01	0.16	0.005		0.6	0.01	0.42	0.007
	0.20	0.01	0.24	0.005		0.61	0.01	0.5	0.008
	0.24	0.01	0.53	0.008		0.62	0.01	0.6	0.009
	0.26	0.01	0.73	0.01		0.64	0.01	0.92	0.01
	0.28	0.01	1.07	0.04		0.65	0.01	1.06	0.03
	0.29	0.01	1.26	0.04		0.66	0.01	1.27	0.03
	0.30	0.01	1.48	0.04		0.67	0.01	1.55	0.05
	0.31	0.01	1.74	0.05		0.68	0.01	1.88	0.05
	0.32	0.01	2.03	0.05		0.7	0.01	2.65	0.06
	C	. 1		c · ·	1 .1	•			

Seguono i loro rispettivi grafici in scala semilogaritmica:

### Caratteristica I-V del diodo al Silicio



### Caratteristica I-V del diodo al Germanio

